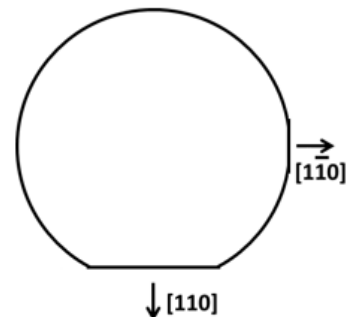


AlGaInP/GaInP 红光半导体激光器外延片说明书

一、基本信息

直径	3/4 inch
厚度	450±25 um ^①
PL 波长	630-670nm
表面取向	(100) 15° Off Toward
定位边标准	US
衬底 EPD	<500 cm ²



外延片示意图

二、外延结构

名称	材料	厚度(Å)	掺杂浓度 (cm ⁻³)
欧姆接触层	GaAs	2000~3000	>1E+19
带隙过渡层	GaInP	200~500	1~5E+18
P 限制层	AlInP	7000~9000	1~2E+18
腐蚀阻挡层	GaInP	~100	1~2E+18
P 限制层	AlInP	1000~2000	1~2E+18
波导层	AlGaInP	500~1500	-
有源区	AlGaInP/GaInP	~200	-
波导层	AlGaInP	500~1500	-
N 限制层	AlInP	8000~10000	0.5~1E+18
过渡层	GaAs	~3000	1~4E+18

说明：①可提供定制尺寸及厚度的外延片。

②部分参数可以根据客户要求定制。